

mercoledì 12 ottobre 2011

di *Roberto Pulito*

A+A-

 Commenti (0)

Samsung e Micron per le memorie 3D

Un consorzio per lavorare sulle DDR3 con una dimensione in più. Specifiche e manuale di istruzioni in arrivo

Roma – La DRAM attuale non è abbastanza veloce da sostenere i nuovi processori multi-core in arrivo. Per questo motivo Samsung sta lavorando da tempo a moduli DDR3 che utilizzano la tecnica chip stacking a tre dimensioni, chiamata **TSV** (Through Silicon Via). Un approccio che impila gli integrati uno sull'altro per far risparmiare strada al flusso dei dati.

Fino a questo momento cinque sviluppatori si sono uniti al colosso sudcoreano per la ricerca e lo sviluppo delle nuove memorie HMC (Hybrid Memory Cube). Attualmente il **consorzio HMC** include **Micron**, Altera, Open-Silicon e Xilinx. Le aziende hanno tutte pari diritto di voto sulle specifiche finali che dovrà avere il prodotto. **Elpida** dovrebbe essere il prossimo a salire sul carro.

Con l'approccio TSV si risparmia potenza, aumentando al tempo stesso densità ed efficienza della memoria in gioco. Samsung e soci ritengono che un unico cubo tridimensionale possa offrire prestazioni 15 volte maggiori rispetto ad un singolo modulo DDR3 DRAM, utilizzando fino al 70 per cento in meno di energia per bit.



What are your employees using
Internet access for?
Find out with GFI WebMonitor

http://facebook.com

GFI WebMonitor™
Web security, monitoring and Internet access control

Ovviamente per far lavorare al meglio CPU e GPU con questo nuovo tipo di memoria bisognerà

[LEGGI ANCHE](#) [ULTIME NOTIZIE](#)

BUSINESS

[Apple, nuova denuncia per Samsung](#)

TECNOLOGIA

[Samsung, Tizen prende il p Bada](#)

BUSINESS

[ITC: Motorola non viola i b Apple](#)

TECNOLOGIA

[Samsung e Intel, insieme p](#)

BUSINESS

[Brevetti USA, la testa è di I](#)

HARDWARE

[Samsung rinnova il Chrom](#)

BUSINESS

[Ultraviolet fa amicizia con e Samsung](#)

TECNOLOGIA

[Telefonando dal CES](#)

TECNOLOGIA

[CES 2012, la cavalcata delle TV](#)

BUSINESS

[Italia, iPhone 4S resterà su scaffali](#)

rivedere le configurazioni hardware. Entro il prossimo anno il consorzio HMC si propone di fornire strumenti e documentazione completa per descrivere le specifiche dell'interfaccia e infilare le memorie 3D nelle macchine.

Roberto Pulito

TAG: [Tecnologia](#), [ram](#), [ddr3](#), [tsv](#), [samsung](#), [micron](#), [altera](#)

 Stampa  Segnala via email

[Tutti di Tecnologia](#) ▶

NOTIZIE COLLEGATE

TECNOLOGIA

Samsung e le DDR3 tridimensionali

Il colosso Coreano presenta 8 Gigabyte di DDR3 da record, basati sulla tecnica 3D che dispone verticalmente la circuiteria. Per aumentare la densità, risparmiare spazio ed energia

TECNOLOGIA

DRAM, Samsung le fa a 20nm

Inizia la produzione di massa per la memoria RAM dinamica da 20 nanometri, in un nuovo stabilimento da record

HOT TOPIC

+ LETTE

+ COMMENTATE

TWITTER

SICUREZZA

Carrier IQ rivoltato come un calzino

SICUREZZA

Windows 7, crash a 64 bit

TECNOLOGIA

Archos 70b e gli altri tablet da 7

ATTUALITÀ

India, assalto ai giganti del web

BUSINESS

Facebook, storie da pubblicizzare

CLOUD

android antitrust **apple**
 browser **copyright** diri
 d'autore facebook gadget
google intel internet **it**
 mercato **microsoft** m
 pirateria privacy ricerca sar
sicurezza smartphon
social network soft
 spazio tablet telefonia twitte

[EMAIL](#) | [INFORMAZIONI SU PI](#) | [PER LA PUBBLICITA' SU PI](#) | [INFORMATIVA](#)



Punto Informatico è testata giornalistica quotidiana - Tribunale di Roma n. 51 del 7.2.1996 De Andreis Editore Srl a socio unico - Gruppo Edizioni Master Spa - P.IVA: 06696301008 - ROC:

Tutti i contenuti pubblicati, salvo diversa indicazione, sono soggetti alla licenza Creative Commons 